

# Silicon PNP Darlington Transistor

## **MPSA63**

30V / 500mA

# DATASHEET

OEM – Valvo

Source: Valvo Datenbuch Transistoren 1989

# MPSA 63

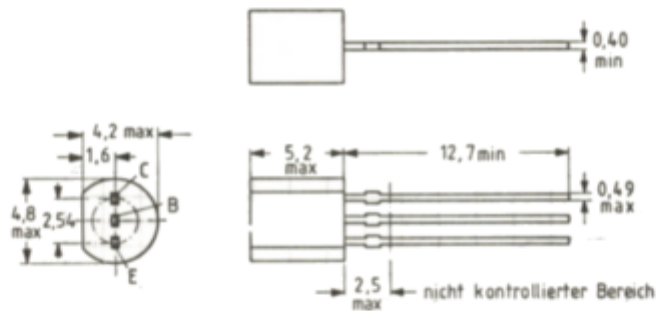
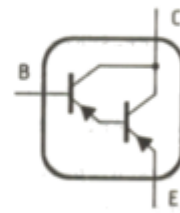
# MPSA 64

SILIZIUM - PNP - PLANAR - EPITAXIAL - DARLINGTON - TRANSISTOREN  
für Verstärker- und Schalter-Anwendungen

### Mechanische Daten:

Gehäuse: Kunststoff,  
JEDEC TO-92

Maßangaben in mm.



VF 720 318.3

Kurzdaten:		MPSA 63	MPSA 64
Kollektor-Sperrspannung	$-U_{CB0} = \text{max.}$	30	V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	$-U_{CES} = \text{max.}$	30	V
Kollektorstrom	$-I_C = \text{max.}$	500	mA
Gesamtverlustleistung bei $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}} = \text{max.}$	625	mW
Sperrschichttemperatur	$\vartheta_J = \text{max.}$	150	$^\circ\text{C}$
Gleichstromverstärkung bei $-U_{CE} = 5\text{ V}$ , $-I_C = 10\text{ mA}$	B $\geq$	5000	10000
Transit-Frequenz bei $-U_{CE} = 5\text{ V}$ , $-I_C = 10\text{ mA}$	$f_T \geq$	125	MHz

## MPSA 63

## MPSA 64

Absolute Grenzwerte: (gültig bis  $\vartheta_{J \max}$ )

Kollektor-Sperrspannung bei  $I_E = 0$ :

Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei  $U_{BE} = 0$ :

Emitter-Sperrspannung bei  $I_C = 0$ :

Kollektorstrom:

Gesamtverlustleistung bei  $\vartheta_U \leq 25^\circ\text{C}$ :

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wärmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Umgebung:

$$-U_{CB0} = \text{max. } 30 \text{ V}$$

$$-U_{CES} = \text{max. } 30 \text{ V}$$

$$-U_{EB0} = \text{max. } 10 \text{ V}$$

$$-I_C = \text{max. } 500 \text{ mA}$$

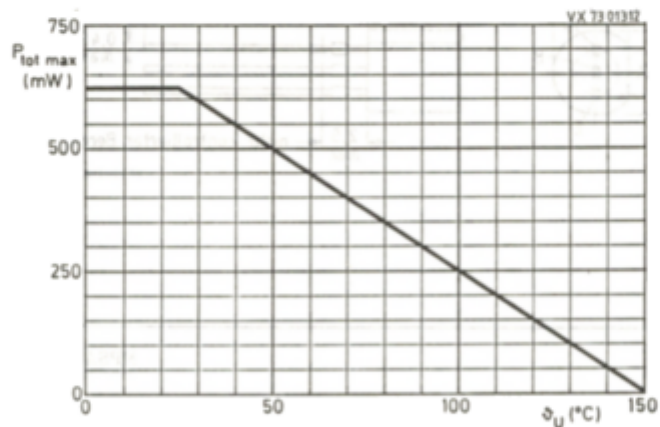
$$P_{\text{tot}} = \text{max. } 625 \text{ mW}$$

$$\vartheta_J = \text{max. } 150 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\vartheta_S = \text{min. } -65 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$\vartheta_S = \text{max. } 150 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$R_{\text{th U}} = 200 \text{ K/W}$$



# MPSA 63

# MPSA 64

<u>Kennwerte:</u>	bei $\vartheta_J = 25^\circ\text{C}$		<u>MPSA 63</u>	<u>MPSA 64</u>
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung bei $U_{BE} = 0, -I_C = 100 \mu\text{A}$ :		$-U_{(BR) CE S} \geq$	30	V
Kollektor-Reststrom bei $I_E = 0, -U_{CB} = 30 \text{ V}$ :		$-I_{CB 0} \leq$	0,1	$\mu\text{A}$
Emitter-Reststrom bei $I_C = 0, -U_{EB} = 10 \text{ V}$ :		$-I_{EB 0} \leq$	0,1	$\mu\text{A}$
Kollektor-Emitter-Restspannung bei $-I_C = 100 \text{ mA}, -I_B = 0,1 \text{ mA}$ :		$-U_{CE sat} \leq$	1,5	V
Basisspannung bei $-U_{CE} = 5 \text{ V}, -I_C = 100 \text{ mA}$ :		$-U_{BE} \leq$	2,0	V
Gleichstromverstärkung bei $-U_{CE} = 5 \text{ V}, -I_C = 10 \text{ mA}$ :		$B \geq$	5000	10000
bei $-U_{CE} = 5 \text{ V}, -I_C = 100 \text{ mA}$ :		$B \geq$	10000	20000
Transit-Frequenz bei $-U_{CE} = 5 \text{ V}, -I_C = 10 \text{ mA}$ und $f_M = 100 \text{ MHz}$ :		$f_T \geq$	125	MHz